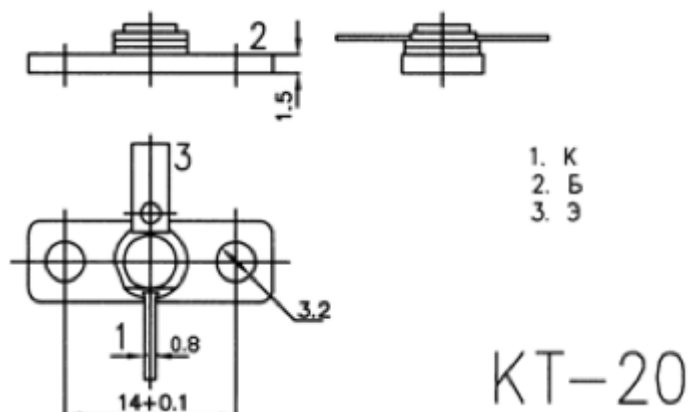


2Т919А

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности, умножителях частоты и автогенераторах в СВЧ диапазоне 0,7...2,4 ГГц в схеме с общей базой.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип корпуса: КТ-20.

Условное обозначение транзисторов 2Т919А - буква «А» и **зеленая точка**.



Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзисторов не более 2 г.

Технические условия: ЖКЗ.365.249 ТУ.

Изготовитель - завод «Пульсар», г. Москва.

Основные технические характеристики транзистора 2Т919А:

- $P_{вых}$ - Выходная мощность транзистора на частоте 2 ГГц при $P_{вх} = 1$ Вт: не менее 3,5 Вт;
- $\eta_{кпд}$ - Коэффициент полезного действия коллектора: не менее 33%;
- $P_{к т max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 10 Вт;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: более 1350 МГц;
- $U_{кб max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база: 45 В;
- $U_{эб max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 3,5 В;
- $I_{к max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 0,7 А;
- $I_{к и max}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 1,5 А;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 45$ В : не более 10 мА;
- $C_{ск}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 10 пФ;
- $t_{к}$ - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 2,2 пс.